






	<h2 style="color: #C00000;">SI7852DP-T1-E3</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">SI7852DP-T1-E3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 80V 7.6A PPAK SO-8
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">SI7852DP-T1-E3.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 23101 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7852DP-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 7.6A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	23101 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 7.6A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.5 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7852DP-T1-E3TR

SI7852DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7852DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7852DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7852DP-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7852DP-T1</b> VISHAY SI7852DP-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI7852DP</b> VISHAY SI7852DP VISHAY</p>	 <p><b>SI7852DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 7.6A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7856ADP-T1</b> Vishay Precision Group SI7856ADP-T1 VISHAY</p>
 <p><b>SI7856ADP</b> SI SI7856ADP SI</p>	 <p><b>SI7852ADP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7852DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 7.6A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7852ADP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI7846DP-T1-E3	 SI7846DP-T1-E3	 SI7846DP-T1-GE3	 SI7846DP-T1-GE3	 SI7846DP-T1
 SI7846SAC	 SI7848BDP-T1-E3	 SI7848BDP-T1-E3	 SI7848BDP-T1-GE3	 SI7848BDP-T1-GE3
 SI7848DP	 SI7848DP-T1-E3	 SI7848DP-T1-E3	 SI7848DP-T1-GE3	 SI7850DP
 SI7850DP-T1-E3	 SI7850DP-T1-E3	 SI7850DP-T1-GE3	 SI7850DP-T1-GE3	 SI7852ADP
 SI7852ADP-T1-E3	 SI7852ADP-T1-E3	 SI7852ADP-T1-GE3	 SI7852ADP-T1-GE3	 SI7852DP
 SI7852DP-T1-E3	 SI7852DP-T1-GE3	 SI7852DP-T1-GE3	 SI7856ADP	 SI7856ADP-T1-E3
 SI7856ADP-T1-E3	 SI7856ADP-T1-GE3	 SI7856ADP-T1-GE3	 SI7856DP-T1	 SI7856DP-T1-GE3
 SI7856DP-TI-E3	 SI7858ADP	 SI7858ADP-T1-E3	 SI7858ADP-T1-E3	 SI7858ADP-T1-GE3
 SI7858ADP-T1-GE3	 SI7858BDP	 SI7858BDP-T1-E3	 SI7860ADP	 SI7860ADP-T1-E3
 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860ADP-T1-GE3	 SI7860ADP-T1-GE3	 SI7860ADP-TI-E3	 SI7860DP

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited